JP 50-131092

2. Claims:

- (1) An electrochemical semiconductor electrode characterized in that an oxide coat of a titanium alloy containing at least one kind of tantalum and niobium of 0.1 to 10 weight %, oxidized in an atmosphere containing oxygen, is used as an electrolysis reaction surface.
- (2) A method of producing an electrochemical semiconductor electrode, as claimed in claim 1, characterized in that an oxide coat of a titanium alloy containing at least one kind of tantalum and niobium of 0.1 to 10 weight %, oxidized in an atmosphere containing oxygen, is used as an electrolysis reaction surface.

At the lower right column at page 1, lines 3-5

As the semiconductor electrode, conventionally, silicon, germanium, and other single crystal of metal oxidation were known.



許

(4) 後 記 号 な し (特許法第 3 8 条)

(特許法第38条) ただし毎の規定 (による特許出額)

昭和49年4月 4日

特 許 庁 長 宜 殿

2. 特許請求の範囲に記載された発明の数

3 港 明 者

住所 東京都品川区二葉 2-9-15

古河電気工業株式会社中央研究所内

、氏名

大灾和哉

4. 特許出願人

住所 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号

名妳

(529)古河電気工業株式会社

代表者 取締役社長 鈴 木 二

5. 代 選 人 (〒100)

住げ

東京部千代田区丸の内 2 丁目 6 诸 1 号

古河域気工業株式会社内 氏名 (5393) 弁選士 植 木

(5393) 弁理士 植 木 (電話 213-0811)

(任か1名)

6. 旅付審点の目録

(1) 明 超 智(2) 姿 任 状

1 通 1 通

(2) 安任 沃(3) 威密叫本

1 通

为。

特许万

49. 4. 5

49-038218

明 細 響

2. 特許前水の範囲

- (1) タンタルおよびニオブの少なくとも1種を0.1 ~10 重量も含有するチタン合金の或化物破膜 を電解反応面とすることを特徴とする電気化学 用半導体電極。
- (2) タンタルおよびニオブの少たくとも1 通を 01 ~10 重量を含有するチタン合金を譲続含有雰 出気中で酸化することを特敵とする特許請求の 地西第1項記載の電気化学用半導体電極の製造 法。

3 発明の詳細な説明

本発明は電気化学的に何電体の授受反応をその <u>久</u>ひり 米面で行うための半導体電極の投資法に係る。

半導体電極級面での電気化学的電極反応は、従来の金属電便級面で行われる反応とは特異を規模が観察されるので注目されている。即ち、半導体には伝導帝と面電子帝の間に禁止エネルギー帝が

19 日本国特許庁

公開特許公報

①特開昭 50-131092

43公開日 昭 50. (1975) 1016

②特願昭 49-382/6

②出願日 昭49 (1974) 4 4

審查請求 未請求

(全3頁)

庁内整理番号 6377 57 7268 4A

ᡚ日本分類 62 A1 13 P13

51) Int. C12.

HOIB 1/08 CZSB 11/04

存在するので光の照射や熱により電気化学反応が 変化を支け易いので復々の反応制調を行い得る。

従来半導体電値としてはシリコン、ゲルマニウム、及びその他の金属 東化物の単結晶などが知られているが、これらの単結晶半導体では広い面積の電極を製造することが困難であり、強度の点でも問題であつた。

本発明はメンタル又はニオブを含むチタン合金の表面を激化することによりチタン含金の設面に 容易にその合金の酸化物吸収(半等体層)を形成 することができることを知見したことに基くもの であり、製造の容易な高強度の半導体電極及びそ の契造法を提供するものである。

チタンは純粋な状態ではその表面で電気化学的
な。成化反応が起り難く、とのことは不動態化現象
として知られている。 従つて純チタンを酸化透元
反応の電極として使用することは不適当である。
また純チタンの表面を成化した場合にもその表面
で延用的な値での酸化反応を行うことはできなか
った。

3 =

-459-

しかるに、チタンにタンタル、ニオブなどの元 業を旅加したチタン合金の表面を酸化したものの 表面上では遠元反応のみならず酸化反応も可能で あることを見出した。

即ち本売明はタンタルおよびニオブの少たくと も1値を01~10重量が含有するチタン合金の 域化物破痕を電解反応面とすることを停留とする 磁気化学用半導体電極を提供するものである。

チタン合金中のタンタル又はニオブの含有域は ①1ないし10重電が選ましいが、①5たいし 5酸電券が特に適する。タンタル又はニオブの含 何頃の少い場合には半導体層の観気伝導度が小さ く、大きな反応電液を待るととができず、他方タ ンタル又はニオブの含有量の多い場合にはチタン 合金の加工性が感く不利である。タンタル又はニ オブを否々単細で含有するチタン合金でも、タン タルとニオブの双方を含有するチタン合金でも共 に使用できる。

半導体の特性及び耐食性を劣化させない範囲内 でタンタル及びニオブ以外の元素をチタン合金に

・2 風最多のニオブを含有するチタン合金を 900 でで感闻圧をしてチタンーニオブ合金板を作つた。 との表面には、感闻圧延の際に空気中の検索で後化 して生成したスケールが形成していた。

この機化被威についたチタンーニオプ合金液を 0.1規定の磁-波中で、飽和甘こり電極に対し、+ 2.0ポルトに分通した場合 0.5 mA/cm² の電流が 愛側されたが、この電極面に 5.00 W のタングス テン母を出対した場合には約1.0 %の電流値の増 加が銀脚され、このチタン合金の姿面には半導体 後級が形成されていることを確認した。

奥地约 2

42 直積多のタンタルを含むチタン合金板を 700℃で1時間望気中で加州し、接面に被化艇 を形成した。

この試料について実施が1と同様の光照射の実 蔵を行ったところ、電流値の増加が説明され半導 体磁域が形成されていることを確認した。

このチタン-タンタル合金系半導体電弧を感返 とし10分m以中で10Vの電圧を印加した場合、 特照 昭50-1310**92**(2) 銃加するとともできる。

本発明の
建気化学用半導体電極は
タンタル又は
ニオブを含むチタン合金の
表面を空気、
峻柔等の
峻密を含む酸化性
雰囲気中で加熱する
ことにより
得ることができる。

即ち、本発明はタンタルおよびニオブの少なく とも1種を0.1~10重量が含有するチタン合金 を酸素含有雰囲気中で加熱して酸化するととを特 散とする電気化学用半導体電極の吸過法を提供す るものである。

加熱温度が低い場合には酸化に長時間要するので300℃以上更に窒ましくは500℃以上であることが必要である。加熱の上限はチタン合金の 磁点以下であるが実用上は1000℃以下でも十 分な速度で装面酸化ができる。

酸化の工程を別に設けなくともチタン合金の熱 同圧延の際には表面酸化を受けるので、との工程 を酸化の工程に代用するとともできる。

次化本発明の実施例を示す。

夹施例 1

50 m^A/cm² の電流が得られ、電極として動作した。

なお比較のために、純チタン夜を同様の条件で 酸化したものを勝極とした場合には10ボルトの 低圧を印加してもほとんど電弧は流れなかつた。

特許出頭人 代理人 植 木



特別 超30-131092 (3)

7. 前記以外の代理人

(7100)

住所 東京部千代田区丸の内2丁目6番1号

古何呢気工菜來式会社内

古何成気工築株式会社内 (7832) 弁理士 若 林 広 志 (電話 213-0811) 氏名

BEST AVAILABLE COPY